

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главного научного сотрудника – заведующего лабораторией
в лаборатории Физики редкоземельных полупроводников
Вакансия VAC_26770

Тематика исследований: Исследования в области физики, химии, технологии и техники редкоземельных полупроводников и разработка на их основе новых полупроводниковых приборов.

Трудовая деятельность: Осуществление научного руководства конкретными темами исследований согласно государственному заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам, а также подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечение выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении. Непосредственное участие в выполнении исследований: разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности соисполнителей работ; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения. Внедрение полученных результатов на промышленных предприятиях, в том числе, разработка и создание технологических линий по производству полупроводниковых приборов. Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области (руководство дипломными и курсовыми работами).

Особенности трудовой деятельности: главный научный сотрудник – заведующий лабораторией Физики редкоземельных полупроводников несет полную материальную ответственность за имущество, закрепленное за лабораторией, а также работает со сведениями, составляющими государственную тайну по ф. 3.

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории Физики редкоземельных полупроводников на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов.

- Наличие ученой степени доктора технических наук.
- Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений не менее 269, в том числе: опубликованных произведений не менее 237 шт., опубликованных периодических изданий не менее 126 шт.
- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования: Web of Science (шт.) не менее 76, Scopus (шт.) не менее 67, Российский индекс научного цитирования (шт.) не менее 167.
- Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе: учтенных в государственных информационных системах не менее 29 шт., имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ не менее 27 шт., имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации не менее 2 шт..

- Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе: подтвержденных актами использования (внедрения) не менее 39 шт., внесенных в качестве вклада в уставной капитал не менее 2 шт.
- Опыт научной работы: не менее 25 лет.
- Опыт научно-организационной работы: не менее 7 лет.

За последние 5 лет руководство не менее чем 3 договорами НИОКР с научно-производственными организациями-заказчиками, не менее чем 3 грантами отечественных и зарубежных фондов, подготовка не менее чем 3 научных кадров высшей квалификации, включая не менее 1 кандидата наук.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).